

## การออกแบบอิเล็ก trod แซมเบอร์ขนาดเล็กสำหรับการพาสเจอร์ไรซ์อาหารเหลว ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์

นิติพงศ์ ปานกลาง\*

### บทคัดย่อ

บทความนี้ นำเสนอการออกแบบและพัฒนาอิเล็ก trod แซมเบอร์ที่พัฒนาขึ้นเป็นแบบสนามไฟฟ้าร่วม ซึ่งเหมาะสมกับการพาสเจอร์ไรซ์อาหารเหลวแบบต่อเนื่อง อิเล็ก trod แซมเบอร์มีแซมเบอร์สำหรับสร้างสนามไฟฟ้าบริเวณ PEF Zone ในลักษณะทรงกระบอกหรือเท่ากับ  $5\text{ mm}$  และมีปริมาตรเท่ากับ  $785 \text{ mm}^3$  จากการคำนวนในทางทฤษฎี การสร้างสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ที่ระดับแรงดัน  $V_0$  เท่ากับ  $30\text{kV}$  และความกว้างของพัลส์เท่ากับ  $1.5\text{s}$  ต้องใช้กำลังไฟฟ้าเท่ากับ  $1\text{MW/mL}$  หรือคิดเป็น พลังงาน  $22.5\text{J/mL}$  เมื่อตัวกลางของเหลวมีความนำไฟฟ้า  $0.3\text{S/m}$  การออกแบบและพัฒนาประยุกต์ให้วิธีไฟในเอกิเม้นต์ช่วยในการวิเคราะห์ความเครียดสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในอิเล็ก trod แซมเบอร์บริเวณ PEF Zone เพื่อศึกษาความเครียดสนามไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามต่อการกำจัดเชื้ออุลิโนทรี จากการวิเคราะห์สนามไฟฟ้า พบว่า ความเครียดสนามไฟฟ้าปรับผันโดยตรงกับแรงดัน  $V_0$  ที่จำเพาะกับอิเล็ก trod แรงดัน  $V_0$  ที่เพิ่มขึ้นมีผลทำให้ความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดมีค่าอยู่ระหว่าง  $2.36\text{kV/mm}$  ถึง  $23.58\text{kV/mm}$  ทั้งนี้ ระดับแรงดัน  $V_0$  ที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดเชื้อแบคทีเรียเชอร์โคไล (E.Coli), แบคทีเรียสแตปปิโลโคคัส ขอเรยส์ (S.Aureus), แบคทีเรียโซโนแนส ฟลูออเรสเซนส์ (P.Fluorescens) และยีสต์เชคโคโรไมเชล ซีรีวิสิเอ (S.Cerevisiae) มีค่าเท่ากับ  $30\text{kV/mm}$  และความเครียดสนามไฟฟ้าบริเวณ PEF Zone มีค่ามากกว่า  $1.5\text{kV/mm}$  ซึ่งมากกว่าสนามไฟฟ้าวิกฤติของเยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อแบคทีเรียและยีสต์ดังกล่าว คำสำคัญ: อิเล็ก trod แซมเบอร์ ไฟในเอกิเม้นต์ การพาสเจอร์ไรซ์ สนามไฟฟ้าแบบพัลส์

## Design of Small Chamber Electrode for Liquid Food Pasteurization by Using Pulse-Electric Field

Nitipong Panklang\*

### Abstract

This paper presents the design and development of small electrode chamber for liquid food pasteurization by using pulse electric field. The developed co-field chamber is suitable for continue pasteurization process. Electric field chamber for buildup electric field inside an electrode chamber at PEF Zone has radius and volume equal to 5mm and  $785\text{mm}^3$  respectively. From theoretical computation, power and energy was used to generate the electric field at PEF Zone about  $15\text{MW/mL}$  and  $22.5\text{J/mL}$  respectively, when the value of  $V_0$  is 30kV,  $1.5\mu\text{s}$  pulse width and conductivity  $0.3\text{S/m}$  of liquid medium. The finite element method is used for electric-field strength analysis at PEF Zone - inner electrode chamber. Therefore, the purpose of this paper is to study intensity of electric field, which is suitable for microorganism inactivation. From the analysis results show that, the electric-field strength was directly proportional to voltage  $V_0$  of electrode. When value of applied voltage  $V_0$  is between 10kV and 100kV, the electric field strength was equal to  $2.36\text{kV/mm}$  -  $23.58\text{kV/mm}$ . In order that, at 30kV of voltage  $V_0$  can be used to inactivate the E.coli, S.Aureus, P.Fluorescens and S.Cerevisiae. Electric field strength at PEF Zone was more than  $1.5\text{kV/mm}$  that also was more than critical electric field of those bacteria and yeast membrane.

**Keywords:** electroporation, finite element, pasteurization, pulsed electric field

---

\* Lecture, Department of Electrical Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi,  
Pathumtani 12110, Email: p.nitipong@gmail.com

## 1. บทนำ

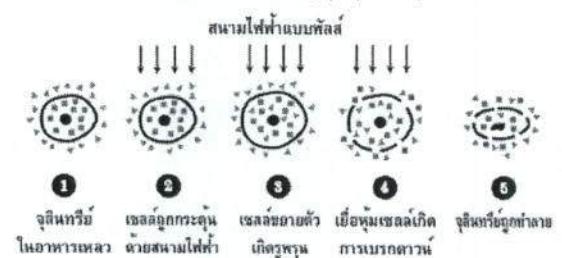
การถนอมอาหารด้วยกระบวนการพัฒนาไฟฟ้า (Pasteurization) และการสเตอริไรซ์ (Sterilization) เป็นวิธีที่นิยมใช้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการถนอมอาหารที่เป็นของเหลว อาทิ เช่น นม น้ำผลไม้ เครื่องดื่มและลูกชอร์ต เป็นต้น การถนอมอาหารด้วยวิธีพัฒนาไฟฟ้าจะใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60 - 80 องศาเซลเซียสในการฆ่าเชื้ออุลิโนทรีทที่ปั่นเป็นอนุญญาตในอาหาร ส่วนการสเตอริไรซ์ การฆ่าเชื้ออุลิโนทรีทต้องใช้อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส ขอเดียวย่างหนึ่งของการใช้ความร้อนในการถนอมอาหารหรือกำจัดเชื้ออุลิโนทรีทคือ อาหารจะเสียคุณค่าทางโภชนาการเนื่องจากความร้อนได้ ความร้อนที่เราใช้ฆ่าเชื้ออุลิโนทรีทยังอาจทำให้ กลิน สี รสชาติของอาหารมีการเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้นความร้อนยังทำลายเอนไซม์ (Enzymes) บางชนิดที่เป็นประโยชน์อีกด้วย

บทความนี้ นำเสนอการออกแบบอิเล็กโทรดแรมเบอร์ขนาดเล็กสำหรับการพัฒนาไฟฟ้าแบบต่อเนื่องโดยไม่ใช้ความร้อน ซึ่งเป็นการกำจัดเชื้ออุลิโนทรีทในอาหารเหลวโดยที่ให้เกิดการเบรกดาวน์ของเยื่อหุ้มเซลล์ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ (Pulse Electric Field) ตามกระบวนการอิเล็กโทรโพเรชัน (Electroporation) การออกแบบอิเล็กโทรดแรมเบอร์ดังกล่าว อาศัยวิธีไฟฟ้าในเอกลิเม้นต์ (Finite Element Method) ทำการวิเคราะห์ความเครียดสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในแรมเบอร์สนามไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสนามไฟฟ้าแรงสูงที่ใช้ในการกำจัดเชื้ออุลิโนทรีทในอาหารเหลว นอกจากนั้น การวิเคราะห์สนามไฟฟ้ายังแสดงให้เห็นถึงระดับความเครียดสนามไฟฟ้าที่เหมาะสมต่อการนำไปประยุกต์ใช้กับการกำจัดเชื้ออุลิโนทรีท แบคทีเรียและยีสต์ชนิดต่างๆ ด้วย

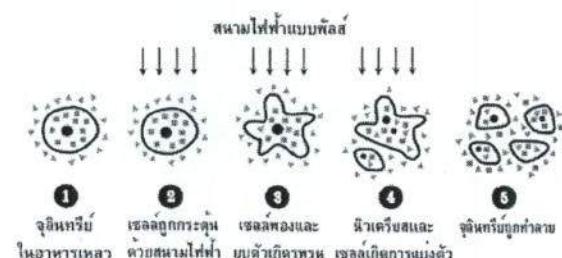
## 2. การกำจัดเชื้ออุลิโนทรีทด้วยสนามไฟฟ้า

การกำจัดเชื้ออุลิโนทรีทและแบคทีเรียที่เป็นอันตรายในอาหารเหลว อาทิ เช่น ซาลโมเนลลา (Salmonella), เอส. เชอริชิยา โคไล (Escherichia Coli, E.Coli) ฯลฯ ด้วยกระบวนการพัฒนาไฟฟ้าหรือการสเตอริไรซ์จำเป็นต้องอาศัยความร้อนที่อุณหภูมิสูง ความร้อนดังกล่าว นอกจาก

จะทำลายเชื้ออุลิโนทรีทแล้ว ยังมีผลต่อคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ทำให้รสชาติ สี กลิ่นเปลี่ยนแปลง และวิตามินบางชนิดถูกทำลาย การกำจัดเชื้ออุลิโนทรีทด้วยสนามไฟฟ้าเป็นวิธีการพัฒนาไฟฟ้าที่ไม่ใช้ความร้อน โดยอาศัยกระบวนการอิเล็กโทรโพเรชันหรือเรียกอีกอย่างว่า Electroporation (Huub และคณะ, 2007) ซึ่งเป็นกระบวนการทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane) โดยใช้สนามไฟฟ้าที่มีความเข้มสูงและมีลักษณะเป็นพัลส์ สนามไฟฟ้าแบบพัลส์ที่มีความเข้มสูงนี้ จะทำให้แรงดันไฟฟ้า (Electric Potential) ที่ตกร่วมกันเยื่อหุ้มเซลล์มีค่าสูงเกินกว่าค่าความคงทนไดอิเลคทริก (Dielectric Strength) ของเยื่อหุ้มเซลล์และทำให้เกิดรูพรุนแบบปอร์โอะฟิบิก (Hydrophobic Pores) จำนวนมากขึ้นที่เยื่อหุ้มเซลล์ รูพรุนแบบปอร์โอะฟิบิกทำให้เกิดการทำลายเทrebะห่วงของเหลวภายในเซลล์ กับไซโทพลาซึม (Cytoplasm) ซึ่งเป็นของเหลวภายในเซลล์ เซลล์จะเกิดการขยายตัวและนำไปสู่การเบรกดาวน์ของเยื่อหุ้มเซลล์ ในที่สุด รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนของกระบวนการอิเล็กโทรโพเรชันที่เกิดขึ้นกับเซลล์ของจุลชีพแบบเน็คโครซิส (Necrosis) และอะพอพโตซิส (Apoptosis)



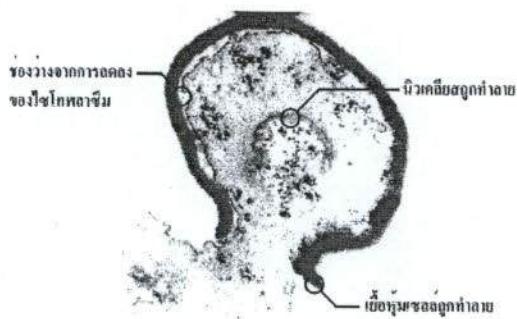
กระบวนการนักโครซิส(Necrosis)



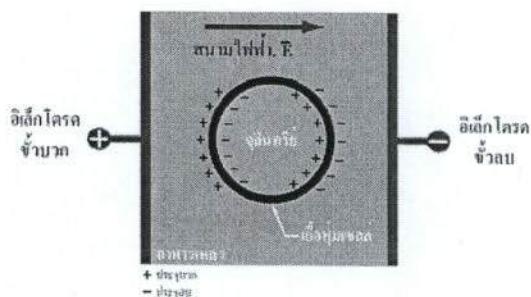
กระบวนการอะพอพโตซิส(Apoptosis)

▲ อาหารเหลว ■ ไซโทพลาซึม ● น้ำเครียด

รูปที่ 1 ลำดับขั้นของกระบวนการอิเล็กโทรโพเรชันที่เกิดขึ้นกับเซลล์ของจุลชีพ



รูปที่ 2 เยื่อหุ้มเซลล์ของยีสต์แซคโคโรไมซิส ซีเรวิสอ้อท์ ก็อกการเบรกดาวน์ เนื่องจากสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ (Gustavo และคณะ, 1999)



รูปที่ 3 ประจุไฟฟ้าที่จะสมบูรณาเยื่อหุ้มเซลล์ เมื่อยู่ภายใต้สนามไฟฟ้า E

จากรูปที่ 1 กระบวนการการตายของเซลล์แบบเน็คโครสิส ก็อกขึ้นเมื่อเซลล์ได้รับความเครียดสนามไฟฟ้า เยื่อหุ้มเซลล์ จะเกิดรูพรุน (Pore) โดยรูพรุนดังกล่าว ต้องเป็นรูพรุนแบบ ไฮdrophobic (Hydrophobic) ซึ่งทำให้เกิดการถ่ายเท ระหว่างของเหลวภายในเซลล์กับของเหลวภายนอกเซลล์ หรือไซโทพลาซึม (Cytoplasm) ทำให้เซลล์เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้น การขยายตัวย่างต่อเนื่องทำให้เยื่อหุ้มเซลล์เบรกดาวน์เป็นส่วนเล็กๆ และนำไปสู่การตายของเซลล์ในที่สุด ในส่วนของกระบวนการการตายของเซลล์แบบพะพอพ โทสิส เมื่อเซลล์ได้รับความเครียดสนามไฟฟ้า เยื่อหุ้มเซลล์ จะเกิดรูพรุนแบบ hydrophobic การถ่ายเทระหว่างของเหลวภายนอกเซลล์กับไซโทพลาซึมทำให้เซลล์เกิดการขยายตัว เช่นเดียวกับกระบวนการเน็คโครสิส แต่การเบรกดาวน์ของเซลล์ตามกระบวนการการอพอพโทสิส จะเกิดจากการแตกตัวของกรดดีออกซีโรบีโนนิวคลีอิก (Deoxyribonucleic Acid) หรือดีเอ็นเอ(DNA) และนิวเคลียส (Nucleus) ภายในเซลล์ กล้ายเป็นเซลล์ขึ้นเล็กๆ ซึ่งทำให้เซลล์เกิดการเสียหายไม่สามารถคงสภาพและนำไปสู่การตายของเซลล์ ภารที่ 2 แสดงลักษณะการเบรกดาวน์ของเยื่อหุ้มเซลล์ของยีสต์แซคโคโรไมซิส ซีเรวิสอ้อท์ (S.Cerevisiae) ตามกระบวนการเน็คโครสิสเนื่องจากสนามไฟฟ้า พัลส์ 40kV/cm และจำนวนพัลส์เท่ากับ 64 พัลส์

จากโครงสร้างทางชีวภาพของเยื่อหุ้มทรีฟิลด์ เราสามารถพิจารณาเยื่อหุ้มเซลล์ในลักษณะของชั้นหนาไฟฟ้า (Electric Insulator) ที่ห่อหุ้มไซโทพลาซึมไว้ภายในไซโทพลาซึมจะเป็นตัวนำไฟฟ้าและมีความนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity) มากกว่าเยื่อหุ้มเซลล์ประมาณ 6 - 8 เท่า (Chen และ Lee, 1994) ด้วยเหตุนี้ บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์จะมีลักษณะคล้ายกับตัวเก็บประจุ (Capacitor) ซึ่งมีชั้นไฟฟ้าคั่นอยู่ตรงกลาง เมื่อเซลล์ของเยื่อหุ้มทรีฟิลด์ที่อยู่ในอาหารเหลวได้รับสนามไฟฟ้าจากภายนอก ประจุบุริเวณเยื่อหุ้มเซลล์จะเกิดการเรียงตัวตามทิศทางของสนามไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 3 ประจุดังกล่าวทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าต่อกันเมื่อยื่อหุ้มเซลล์และแรงทางกลในรูปของความเค้นทางไฟฟ้า (Electromechanical Stress) ขึ้น แรงดันไฟฟ้าต่อกันเมื่อยื่อหุ้มเซลล์สามารถคำนวณได้จากสมการ (Schoenbach และคณะ, 1997)

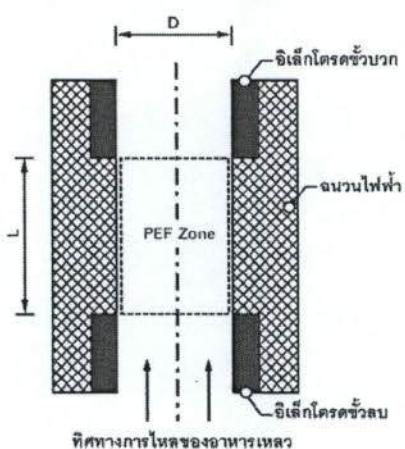
$$U_c = f a_0 E_c \quad (1)$$

เมื่อ  $U_c$  คือแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ต่อกันเมื่อยื่อหุ้มเซลล์,  $f$  คือค่าคงที่ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปร่างของเซลล์,  $a_0$  คือรัศมีวงนอกเซลล์และ  $E_c$  คือความเครียดสนามไฟฟ้าวิกฤติ

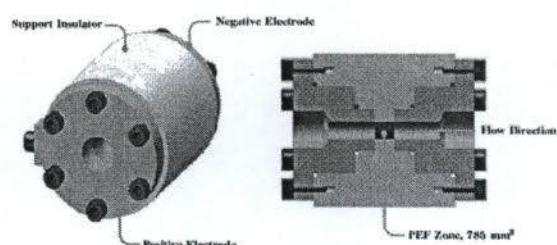
### 3. การออกแบบอิเล็กโทรดแบบเบอร์

อิเล็กโทรดแบบเบอร์เป็นอุปกรณ์สำหรับสร้างสนามไฟฟ้าในการกำจัดเยื่อหุ้มทรีฟิลด์ในอาหารเหลว ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ อิเล็กโทรดแบบเบอร์แบบบากลุ่ม (Batch Chamber), อิเล็กโทรดแบบเบอร์แบบสนามไฟฟ้าตัดขวาง (Cross-Field Chamber) และ อิเล็กโทรดแบบเบอร์แบบสนามไฟฟ้าร่วม (Co-Field Chamber) งานวิจัยนี้ ทำการออกแบบและพัฒนาอิเล็กโทรดแบบเบอร์แบบ

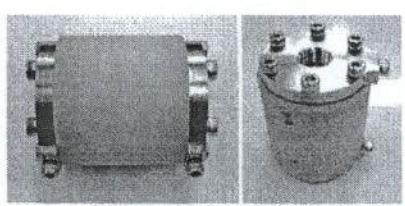
สนาณไฟฟ้าร่วม โดยมีโครงสร้างพื้นฐานดังแสดงในรูปที่ 4 อิเล็กโทรดชั้มเบอร์จะประกอบด้วย อิเล็กโทรดชั้วบาก และชั้วลบที่ถูกยึดติดอยู่บนจนวน โดยให้มีระยะห่างระหว่าง อิเล็กโทรดทั้งสอง ซึ่งเป็นบริเวณที่ใช้สร้างสนาณไฟฟ้า เพื่อกำจัดเชื้อจุลทรรศน์หรือเรียกว่า PEF Zone อาหารเหลวที่เราต้องการพาสเจอร์เรซจะถูกส่งผ่านบริเวณ PEF Zone ในขณะที่เราจ่ายแรงดันให้กับอิเล็กโทรด



รูปที่ 4 โครงสร้างพื้นฐานของอิเล็กโทรดชั้มเบอร์แบบสนาณไฟฟ้าร่วม



รูปที่ 5 แบบจำลอง 3 มิลิเมตรอิเล็กโทรดชั้มเบอร์แบบสนาณไฟฟ้าร่วม



รูปที่ 6 อิเล็กโทรดชั้มเบอร์แบบสนาณไฟฟ้าร่วม

การกำหนดขนาดของอิเล็กโทรดชั้มเบอร์และขนาดของชั้มเบอร์บริเวณ PEF Zone จะถูกกำหนดด้วยพารามิเตอร์สองตัวได้แก่ ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด

ชั้วบากและชั้วลบ(L) และเส้นผ่านศูนย์กลางวงในของ อิเล็กโทรดชั้มเบอร์(D) ในกราฟของการออกแบบอัตราส่วน L/D > 1 เพื่อป้องกันการเบรกดาวน์ระหว่างอิเล็กโทรดที่อาจจะเกิดขึ้น แต่อัตราส่วน L/D ก็ต้องไม่มากจนเกินไป จนทำให้ความเครียดสนาณไฟฟ้ามีค่าต่ำหรือต้องใช้แรงดันไฟฟ้าที่สูงมากเพื่อให้มีความเครียดสนาณไฟฟ้าสูงๆ บทความนี้ออกแบบอิเล็กโทรดชั้มเบอร์ให้มีระยะ L เท่ากับ 10 mm และระยะ D เท่ากับ 10 mm ซึ่งมีอัตราส่วน L/D = 1.0

วัสดุที่เลือกมาทำอัตโนมัติและอิเล็กโทรดได้แก่ โพลีเอไมด์ (Polyamide) และเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 316 (Stainless Steel, SUS316L) เนื่องจากต้องสัมผัสกับอาหารโดยตรง แบบจำลอง 3 มิลิเมตรอิเล็กโทรดชั้มเบอร์มีลักษณะตั้งรูปที่ 5 อิเล็กโทรดชั้มเบอร์จะประกอบด้วยอิเล็กโทรดชั้วบาก (Positive Electrode) และอิเล็กโทรดชั้วลบ (Negative Electrode) ที่ถูกยึดติดกับจนวนโพลีเอไมด์ภายในจนวนมีชั้มเบอร์ทรงกระบอกวัสดุเท่ากับ 5 mm และมีปริมาตรเท่ากับ  $785 \text{ mm}^3$  รูปที่ 6 แสดงส่วนประกอบต่างๆ และลักษณะของอิเล็กโทรดชั้มเบอร์แบบสนาณไฟฟ้าร่วมที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจำกัดอย่างหนึ่งของอิเล็กโทรดชั้มเบอร์แบบสนาณไฟฟ้าร่วม คือ ขนาดไฟฟ้าภายในอิเล็กโทรดชั้มเบอร์บริเวณ PEF Zone จะค่อนข้างไม่สม่ำเสมอ แต่มีความเหมาะสมกับการทำจัดเชื้อจุลชีพแบบกระบวนการต่อเนื่อง

อาหารเหลวที่ไหลผ่านอิเล็กโทรดชั้มเบอร์จะได้รับสนาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างอิเล็กโทรดชั้วบากและชั้วลบบริเวณ PEF Zone รวมถึงมีกระแสไฟฟ้าบางส่วนไหลผ่านอาหารเหลว อินพิดเคนซ์ของอาหารเหลวบริเวณ PEF Zone สามารถคำนวณได้จากสมการ(Huib และคณะ, 2007)

$$Z = \frac{(L + 0.254D)}{\frac{1}{4}\sigma\pi D^2} \quad (2)$$

เมื่อ Z คืออินพิดเคนซ์ของตัวกลางของเหลวบริเวณ PEF Zone ( $\Omega/\text{m}^2$ ), L คือระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดบริเวณ PEF Zone(m), D คือเส้นผ่านศูนย์กลางภายในบริเวณ PEF

Zone(m) และ σ คือค่าความนำไฟฟ้าของตัวกลางข่องเหลว(S/m)

การสร้างสนามไฟฟ้าภายในอิเล็กโทรดแซมเบอร์บริเวณ PEF Zone ทำโดยการจ่ายแรงดันที่มีลักษณะเป็นพัลส์ให้กับอิเล็กโทรดแซมเบอร์ เมื่อเราไม่คำนึงถึงอัตราการไหลของตัวกลางข่องเหลวที่ในหน้า PEF Zone กำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการสร้างสนามไฟฟ้าต่อพัลส์แรงดันหนึ่งรูปคลื่นสามารถคำนวณได้จากสมการ (Hubb และคณะ, 2007)

$$P_{pulse} = \sigma E^2 V_{CH} \quad (3)$$

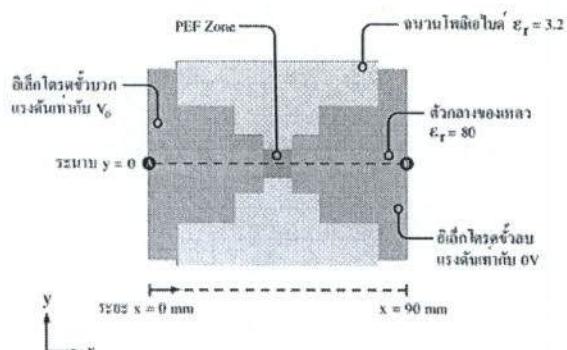
เมื่อ  $P_{pulse}$  คือกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการสร้างสนามไฟฟ้าต่อพัลส์หนึ่งลูก (W), σ คือความนำไฟฟ้าของตัวกลางข่องเหลว(S/m), E คือความเครียดสนามไฟฟ้า (V/m) และ  $V_{CH}$  คือปริมาตรของอิเล็กโทรดแซมเบอร์บริเวณ PEF Zone ( $m^3$ )

#### 4. การวิเคราะห์ผลด้วยคอมพิวเตอร์

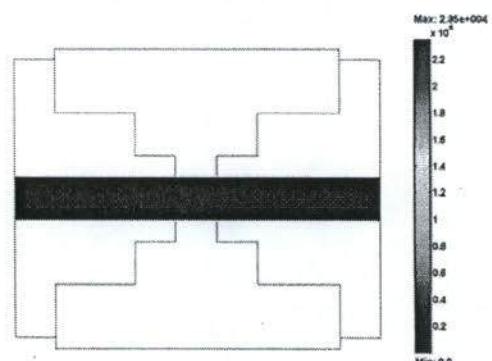
จากอิเล็กโทรดแซมเบอร์ที่ได้ออกแบบและพัฒนาผู้เขียนได้สร้างแบบจำลอง 2 มิติเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเครียดสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในอิเล็กโทรดแซมเบอร์แบบจำลองประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ อิเล็กโทรดชั้นวางมีแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ  $V_0$  อิเล็กโทรดชั้นลับมีแรงดันไฟฟ้าเท่ากับศูนย์ไวลด์ ฉนวนโพลิเอีมิดที่รองรับอิเล็กโทรดทั้งสองมีค่าคงที่ไดอิเล็กต릭 (Dielectric Constant) เท่ากับ 3.2(Philippe, 1988) ตัวกลางข่องเหลวภายในอิเล็กโทรดแซมเบอร์กำหนดให้เป็นน้ำ ซึ่งมีค่าคงที่ไดอิเล็กต릭เท่ากับ 80 แบบจำลองจะละเอียดส่วนที่เป็นโวริงและบริเวณอต ย์ดอิเล็กโทรดชั้นวางและลบ การคำนวณไม่คิดประจุด่าง ( $\rho_0$ ) ที่เกิดขึ้นบริเวณด้านนำและฉนวน องค์ประกอบต่างๆ ของแบบจำลองแสดงดังรูปที่ 7

การวิเคราะห์สนามไฟฟ้าใช้วิธีไฟในอิเลมเนต (Reece และ Preston, 2000) และกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนยินยอม(Tolerance) ของผลเฉลยเท่ากับ  $1 \times 10^{-6}\%$  การคำนวณแบบจำลองจะถูกแบ่งออกเป็น

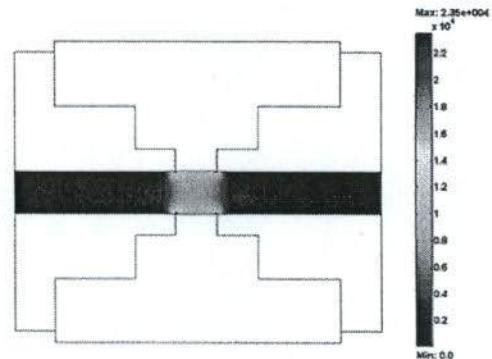
เอกลิเมนต์สามเหลี่ยมกำลังสองคลากรอง (Lagrange-Quadratic Triangular Element) จำนวน 10,024 เอกลิเมนต์ และการแก้สมการเพื่อหาผลเฉลยใช้วิธีตกลงต่ำสุดแบบ ว่างนัยทั่วไป (Generalized Minimal Residual Method, GMRES)



รูปที่ 7 แบบจำลองอิเล็กโทรดแซมเบอร์ 2 มิติ

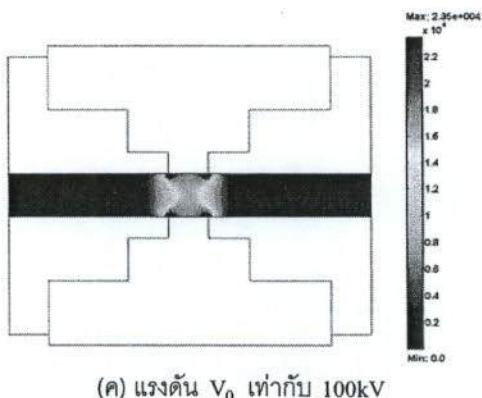
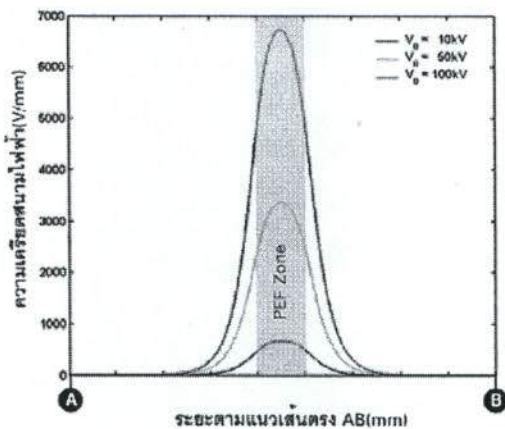


(g) แรงดัน  $V_0$  เท่ากับ 10kV

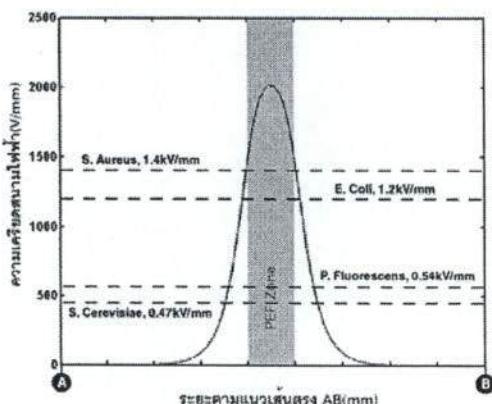


(h) แรงดัน  $V_0$  เท่ากับ 50kV

รูปที่ 8 ความเครียดสนามไฟฟ้าบริเวณภายในอิเล็กโทรดแซมเบอร์ที่ระดับแรงดัน  $V_0$  ต่างๆ

(ค) แรงดัน  $V_0$  เท่ากับ 100KVรูปที่ 8 ความเครียดสนามไฟฟ้าบริเวณภายในอิเล็กโทรดชั้นห้องน้ำที่ระดับแรงดัน  $V_0$  ต่างๆ (ต่อ)

รูปที่ 9 ความเครียดสนามไฟฟ้าตามแนวแกน x ที่ระนาบ y = 0 ระหว่างจุด A กับจุด B ที่ระดับแรงดัน 10KV, 50KV และ 100KV



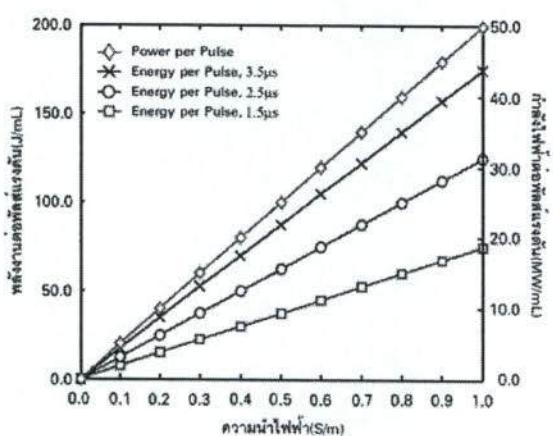
รูปที่ 10 ความเครียดสนามไฟฟ้าตามแนวแกน x ที่ระนาบ y = 0 ระหว่างจุด A กับจุด B ที่ระดับแรงดัน 30KV

รูปที่ 8 แสดงผลการจำลองความเครียดสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในอิเล็กโทรดและชั้นห้องน้ำ เมื่อยื่นแรงดัน  $V_0$  เท่ากับ 10 KV, 50 KV และ 100 KV ตามลำดับ ส่วนความเครียดสนามไฟฟ้าตามแนวแกน x ที่ระนาบ y = 0 ระหว่างจุด A กับจุด B ที่ระดับแรงดัน  $V_0$  เท่ากับ 10 KV, 50 KV และ 100 KV แสดงดังรูปที่ 9 ความเครียดสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะแปรผันโดยตรงกับแรงดัน  $V_0$  โดยการเพิ่มแรงดัน  $V_0$  ทำให้ความเครียดสนามไฟฟ้าบริเวณ PEF Zone เพิ่มขึ้นด้วยและยังมีความสม่ำเสมอมากกว่าที่แรงดัน  $V_0$  ที่ต่ำๆ

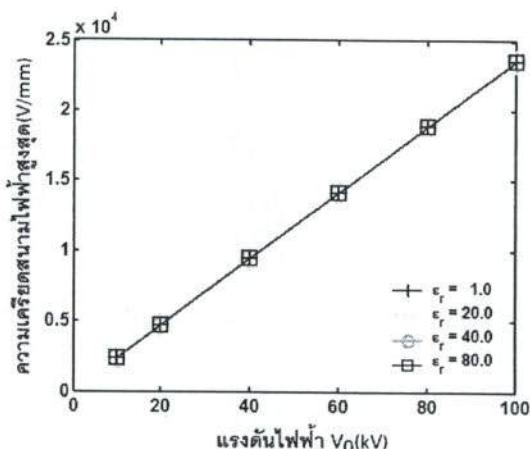
การเลือกแรงดัน  $V_0$  ที่เหมาะสมสำหรับการทำจัดห้องน้ำ สามารถพิจารณาจากสนามไฟฟ้าวิกฤติของเยื่อหุ้มเซลล์ (Critical Electric Field of Membrane) โดยเชื้อแบคทีเรียเอสเซอริเชียโคไล (E.Coli) มีสนามไฟฟ้าวิกฤติของเยื่อหุ้มเซลล์ประมาณ 1.2 KV/mm (Grahl และ Markl, 1996) ดังนั้นแรงดัน  $V_0$  ที่เหมาะสมสำหรับการทำจัดห้องน้ำที่ใช้เชื้อแบคทีเรียเอสเซอริเชียโคไลด้วยอิเล็กโทรดและชั้นห้องน้ำขึ้นเท่ากับ 30KV ซึ่งเป็นแรงดันที่ทำให้ความเครียดสนามไฟฟ้าบริเวณ PEF Zone ตามแนวเส้นตรง AB มีค่ามากกว่า 1.5 KV/mm และมีความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดตรงรอยต่อระหว่างชั้นห้องน้ำกับอิเล็กโทรด ข้างบนและข้างล่างเท่ากับ 7.065 KV/mm นอกจากนี้ที่ระดับแรงดัน  $V_0$  เท่ากับ 30 KV ความเครียดสนามไฟฟ้าบริเวณ PEF Zone ตามแนวเส้นตรง AB ยังมีค่ามากกว่าสนามไฟฟ้าวิกฤติของเยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อแบคทีเรียสแต็ปฟิโลโคคัส ออเรียส (S.Aureus), แบคทีเรียฟูโรเม็นส์ ฟลูออเรสเซนส์ (P.Fluorescens) และยีสต์เชคโคโนไมซิส ซีเรวิสัย (S.Cerevisiae) ดังแสดงในรูปที่ 10 จากสมการที่ (3) เมื่อเราจ่ายแรงดัน  $V_0$  เท่ากับ 30 KV ให้กับอิเล็กโทรดและชั้นห้องน้ำโดยกำหนดให้แรงดัน  $V_0$  มีลักษณะเป็นพัลส์ สี่เหลี่ยมที่มีความกว้างเท่ากับ 1.5 ms และตัวนำของเหลวมีความนำไฟฟ้าเท่ากับ 0.3 S/m กำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการสร้างสนามไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากับ 15 MW/mL คิดเป็นพลังงาน 22.5 J/mL หรือเท่ากับ 0.00000625 kWh/mL จากการคำนวณจะเห็นว่ากำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการสร้างสนามไฟฟ้ามีค่าสูงถึง 15 MW/mL แต่ในทางปฏิบัติกำลังไฟฟ้า

เจลี่ที่ใช้จริงจะมีค่าต่ำกว่า เนื่องจากแรงดันที่จ่ายให้กับอิเล็กโทรดแซมเบอร์มีระยะเวลาต่อครั้งสั้นมาก รูปที่ 11 แสดงค่ากำลังไฟฟ้าและพลังงานที่ใช้ในการสร้างสนามไฟฟ้าที่ค่าความนำไฟฟ้าของตัวกลางของเหลว  $0.1 \leq \sigma \leq 1.0$  เมื่อกำหนด  $E = 7.065 \text{ kV/mm}$  และพัลส์แรงดัน  $V_0$  เป็นพัลส์สี่เหลี่ยมที่มีความกว้างเท่ากับ  $1.5\mu\text{s}$ ,  $2.5\mu\text{s}$  และ  $3.5\mu\text{s}$  ตามลำดับ

รูปที่ 12 แสดงความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดภายในอิเล็กโทรดแซมเบอร์ที่ระดับแรงดัน  $V_0$  ต่างๆ เมื่อตัวกลางของเหลวมีค่าคงที่โดยอิเล็กตริก ( $\epsilon_r$ ) เท่ากับ 1, 20, 40 และ 80 ตามลำดับ ความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดจะเกิดบริเวณจุดต่อระหว่างอิเล็กโทรดขั้วบวกกับจุดนวนโพลิเอทิลีนด์และระหว่างอิเล็กโทรดขั้วลบกับจุดนวนโพลิเอทิลีนด์ เมื่อจ่ายแรงดัน  $V_0$  ที่ค่าระหว่าง  $10\text{kV}$  จนถึง  $100\text{kV}$  ความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดมีค่าอยู่ระหว่าง  $2.36 \text{ kV/mm}$  ถึง  $23.58 \text{ kV/mm}$  นอกจากร้านจากการวิเคราะห์สนามไฟฟ้ายังพบว่า การเปลี่ยนแปลงค่าคงที่โดยอิเล็กตริกของตัวกลางของเหลวไม่มีผลต่อความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้นบริเวณอิเล็กโทรดแซมเบอร์หรือบริเวณ PEF Zone แต่อย่างใด



รูปที่ 11 กำลังไฟฟ้าและพลังงานที่ใช้ในการสร้างสนามไฟฟ้าที่ค่าความนำไฟฟ้าของตัวกลางของเหลว  $0.1 \leq \sigma \leq 1.0$



รูปที่ 12 ความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดภายในอิเล็กโทรดแซมเบอร์ที่ระดับแรงดัน  $V_0$  ต่างๆ เมื่อ  $\epsilon_r$  เท่ากับ 1, 20, 40 และ 80 ตามลำดับ

## 5. สรุป

งานวิจัยนี้ นำเสนองการออกแบบและพัฒนาอิเล็กโทรดแซมเบอร์แบบสนามไฟฟ้าร่วมขนาดเล็กที่สามารถนำไปใช้สำหรับการพยาสเจอร์รีซอาหารเหลวด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ อิเล็กโทรดแซมเบอร์ประกอบด้วยอิเล็กโทรดขั้วบวก (Positive Electrode) และอิเล็กโทรดขั้วลบ (Negative Electrode) ที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 316 อิเล็กโทรดทั้งสองจะถูกยึดติดกับจุดนวนโพลิเอทิลีนที่ภายในขนาดมีช่องว่างหรือช่องว่างที่จะรองรับอุปกรณ์ที่ต้องติดตั้ง เช่น หัวฉีด หัวสูบ ฯลฯ ที่มีความกว้าง  $5 \text{ mm}$  และมีปริมาตรเท่ากับ  $785 \text{ mm}^3$  การออกแบบได้ประยุกต์ใช้วิธีไฟในเอกลักษณ์ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ความเครียดสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในบริเวณ PEF Zone จากการวิเคราะห์พบว่า ความเครียดสนามไฟฟ้าจะแปรผันโดยตรงกับแรงดัน  $V_0$  ที่จ่ายให้กับอิเล็กโทรด โดยการเพิ่มแรงดัน  $V_0$  ทำให้ความเครียดสนามไฟฟ้าในบริเวณ PEF Zone เพิ่มขึ้นด้วย ระดับแรงดัน  $V_0$  ที่เหมาะสมสำหรับการทำจัดเรื่องแบบที่เรียกชื่อว่า "ดีไซน์" แบบที่เรียกชื่อว่า "ดีไซน์" ของอุปกรณ์ ซึ่งเป็นแรงดันที่ทำให้ความเครียดสนามไฟฟ้าในบริเวณ PEF Zone มีค่ามากกว่าสนามไฟฟ้าที่ติดข้อง เช่น หัวฉีด หัวสูบ ฯลฯ ของอุปกรณ์ที่ต้องติดตั้งกับอิเล็กโทรดแซมเบอร์

ในส่วนของกำลังไฟฟ้าและพลังงานที่ใช้ในการสร้างสนามไฟฟ้าแบบพัลส์เพื่อกำจัดเชื้ออุลิโนทรีเย่เปรียบเท่ากับความนำไฟฟ้าของตัวกลางของเหลวและความกว้างของพัลส์แรงดัน  $V_0$  ที่จำเป็นกับอิเล็กโทรดแซมเบอร์ โดยที่ระดับแรงดัน  $V_0$  เท่ากับ  $30\text{ kV}$  และลักษณะแรงดัน  $V_0$  เป็นพัลส์สี่เหลี่ยมที่มีความกว้างเท่ากับ  $1.5\text{ ms}$  กำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการสร้างสนามไฟฟ้าเพื่อกำจัดเชื้ออุลิโนทรีเย่ในตัวกลางของเหลวที่มีความนำไฟฟ้า  $0.38/\text{m}$  จะมีค่าเท่ากับ  $15\text{ MW/mL}$  หรือคิดเป็นพลังงาน  $22.5\text{ J/mL}$

ทั้งนี้ อิเล็กโทรดแซมเบอร์ที่ออกแบบและพัฒนาในบทความนี้ เป็นเพียงอุปกรณ์ส่วนหนึ่งสำหรับการพาราสเจอร์ร์อาหารเหลวและต้องนำไปพัฒนาต่ออย่างร่วมกับอุปกรณ์สร้างสัญญาณพัลส์ไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์วัดและควบคุมแรงดัน อุปกรณ์จัดเก็บและควบคุมการไหลของอาหารเหลว เพื่อเป็นระบบสำหรับทำการพาราสเจอร์ร์อาหารเหลวที่สมบูรณ์ต่อไป ซึ่งผู้เขียนกำลังอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา

## 6. เอกสารอ้างอิง

- Chen, W. and Lee, R. (1994). Altered ion channel conductance and ionic selectivity induced by large imposed membrane potential pulse. *Biophysical Journal*. Vol.67, Issue 2, 603 - 612.
- Grahl, T. and Markl, H. (1996). Killing of Microorganisms by Pulse Electric Fields. *Applied Microbiology and Biotechnology*. Vol.45, 148 - 157.
- Gustavo V. Barbosa-Canovas, Usha R. Pothakamury, M. Marcela Gongora-Nieto, Barry G. Swanson (1999). Preservation of Foods with Pulsed Electric Fields, in Chapter 3, 1<sup>st</sup> ed., Academic Press.

- Huub Lelieveld, Servé Notermans, Sjoerd de Haan (2007). Food Preservation by Pulse Electric Field: From Research to Application, in Chapter 2, 1<sup>st</sup> ed., Woodhead Publishing Limited.
- Huub Lelieveld, Servé Notermans, Sjoerd de Haan (2007). Food Preservation by Pulse Electric Field: From Research to Application, in Chapter 3, 1<sup>st</sup> ed., Woodhead Publishing Limited.
- Huub Lelieveld, Servé Notermans, Sjoerd de Haan (2007). Food Preservation by Pulse Electric Field: From Research to Application, in Chapter 4, 1<sup>st</sup> ed., Woodhead Publishing Limited.
- Philippe Robert (1988). Electrical and Magnetic Properties of Materials, in Chapter 4, 1<sup>st</sup> ed., Artech House Inc.
- Reece, A.B.J. and Preston, T.W. (2000). Finite Element Methods in Electrical Power Engineering, in Chapter 4, 1<sup>st</sup> ed., Oxford University Press Inc.
- Schoenbach, K. H., Peterkin, F. E., Alden, R. W., Beebe, S.J. (1997). The effect of pulsed electric field on biological cell: Experiment and application. *IEEE Transactions Plasma Science*. Vol.25, No.2, 284 - 292.